

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005 年 10 月 6 日 (06.10.2005)

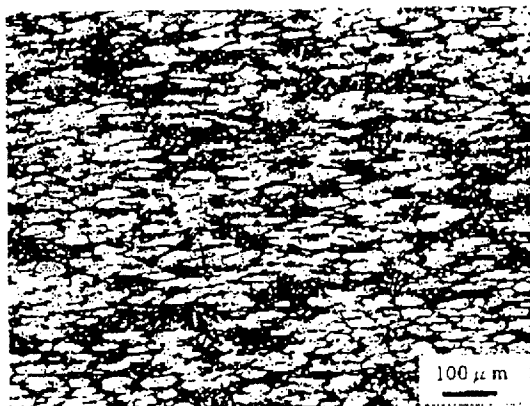
PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2005/093124 A1

- (51) 国際特許分類: C23C 14/34, C22C 19/07, H01F 10/16, 41/18
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2005/002221
- (22) 国際出願日: 2005 年 2 月 15 日 (15.02.2005)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願2004-092645 2004 年 3 月 26 日 (26.03.2004) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社日鉱マテリアルズ (NIKKO MATERIALS CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1050001 東京都港区虎ノ門二丁目 10 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 中村 祐一郎 (NAKAMURA, Yuichiro) [JP/JP]; 〒3191535 茨城県北茨城市華川町白場 1 8 7 番地 4 株式会社日鉱マテリアルズ磯原工場内 Ibaraki (JP). 久野 晃 (HISANO, Akira) [JP/JP]; 〒3191535 茨城県北茨城市華川町白場 1 8 7 番地 4 株式会社日鉱マテリアルズ磯原工場内 Ibaraki (JP).
- (74) 代理人: 小越 勇 (OGOSHI, Isamu); 〒1050002 東京都港区愛宕一丁目 2 番 2 号 虎ノ門 9 森ビル 3 階 小越国際特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:  
— 国際調査報告書
- 2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: Co-Cr-Pt-B BASED ALLOY SPUTTERING TARGET

(54) 発明の名称: Co-Cr-Pt-B 系合金スパッタリングターゲット



総圧延率: 約 30%

ROLLING REDUCTION: APPROXIMATELY 30 %

(57) Abstract: A Co-Cr-Pt-B based alloy sputtering target, characterized in that it has a rolled structure of an island form comprising a Co-rich phase being based on a primary crystal in casting; and the Co-Cr-Pt-B based alloy sputtering target wherein the rolled structure of an island form has an average size of 200  $\mu$ m or less. The Co-Cr-Pt-B based alloy sputtering target can be reduced in the segregation and the residual stress caused in the casting and can have a uniform and fine rolled structure, which results in the prevention or inhibition of the generation of particles and in the improvement in the product yield in film forming. Further, said target can be produced with stability at a low cost.

(57) 要約: 鑄造時の初晶をベースとした Co リッチ相からなる島状の圧延組織を備えていることを特徴とする Co-Cr-Pt-B 系合金スパッタリングターゲット。島状の圧延組織が平均寸法 200  $\mu$ m 以下である同 Co-Cr-Pt-B 系合金スパッタリングターゲット。鑄造時の偏析や残留応力の少ない、均一微細な圧延組織を有す

る Co-Cr-Pt-B 系合金スパッタリングターゲットに関し、該ターゲットを安定して、かつ低コストで製造できるようにするとともに、パーティクルの発生を防止又は抑制し、成膜の製品歩留りを上げることを目的とする。